

XN0A312 (XN1A312)

シリコンNPNエピタキシャルプレーナ形(Tr1部)

シリコンPNPエピタキシャルプレーナ形(Tr2部)

一般増幅用

■ 特 長

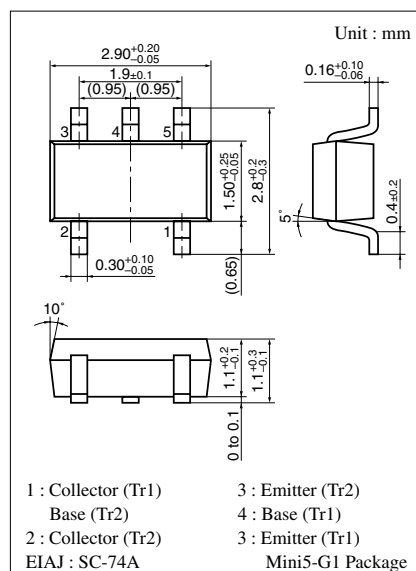
- 1パッケージに2素子内蔵
(抵抗内蔵トランジスタ, Tr1とTr2ベースを接続)
- 実装面積とアセンブリコストの半減が可能

■ 使用素子基本形名

- UNR1212 (UN1212) + UNR1112 (UN1112)

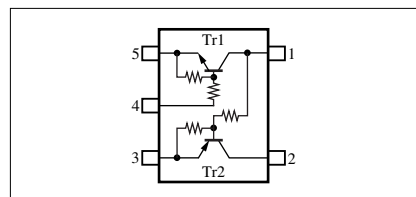
■ 絶対最大定格 $T_a = 25^\circ\text{C}$

項目	記号	定格	単位
Tr1	コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	50 V
	コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	50 V
	コレクタ電流	I_C	100 mA
Tr2	コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	-50 V
	コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	-50 V
	コレクタ電流	I_C	-100 mA
総合	全損失	P_T	300 mW
	接合部温度	T_j	150 $^\circ\text{C}$
	保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150 $^\circ\text{C}$



形名表示記号 : 4P

内部接続図



■ 電気的特性 $T_a = 25^\circ\text{C}$

- Tr1 部

項目	記号	条件	最小	標準	最大	単位
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	$I_C = 10 \mu\text{A}, I_E = 0$	50			V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_C = 2 \text{ mA}, I_B = 0$	50			V
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 50 \text{ V}, I_E = 0$			0.1	μA
	I_{CEO}	$V_{CE} = 50 \text{ V}, I_B = 0$			0.5	μA
エミッタ遮断電流	I_{CEO}	$V_{CE} = 6 \text{ V}, I_C = 0$			0.2	mA
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE} = 10 \text{ V}, I_C = 5 \text{ mA}$	60			
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 10 \text{ mA}, I_B = 0.3 \text{ mA}$			0.25	V
出力電圧 "H" レベル	V_{OH}	$V_{CC} = 5 \text{ V}, V_B = 0.5 \text{ V}, R_L = 1 \text{ k}\Omega$	4.9			V
出力電圧 "L" レベル	V_{OL}	$V_{CC} = 5 \text{ V}, V_B = 2.5 \text{ V}, R_L = 1 \text{ k}\Omega$			0.2	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CB} = 10 \text{ V}, I_E = -1 \text{ mA}, f = 200 \text{ MHz}$		150		MHz
入力抵抗	R_1		-30%	22	+30%	k Ω
抵抗比率	R_1/R_2		0.8	1.0	1.2	

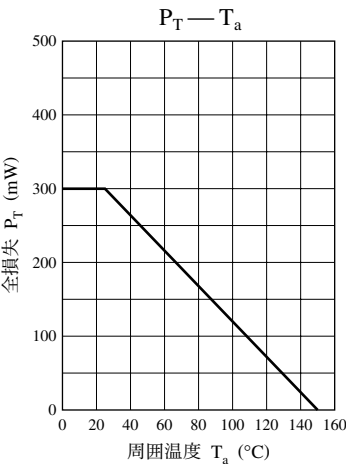
注) 形名の()内は、従来品番です

■ 電気的特性(つづき) $T_a = 25^\circ\text{C}$

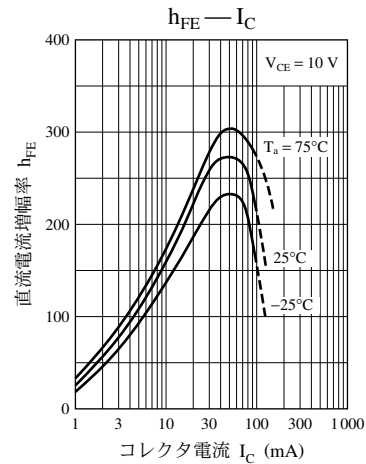
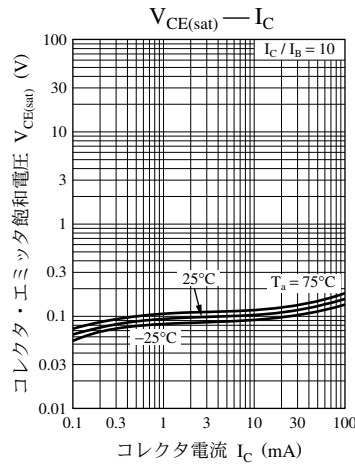
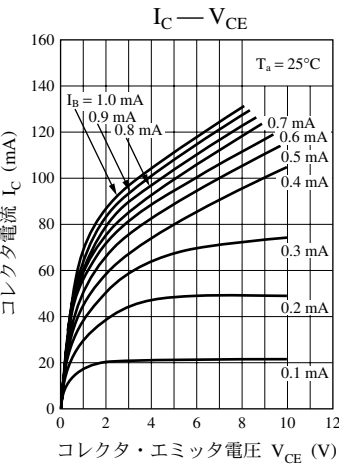
• Tr2 部

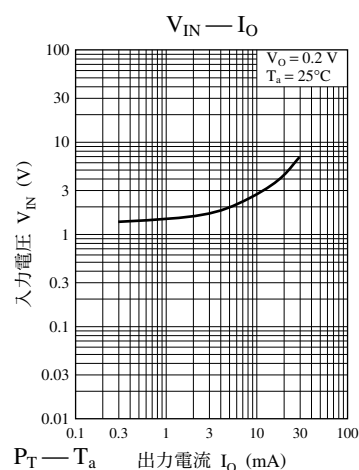
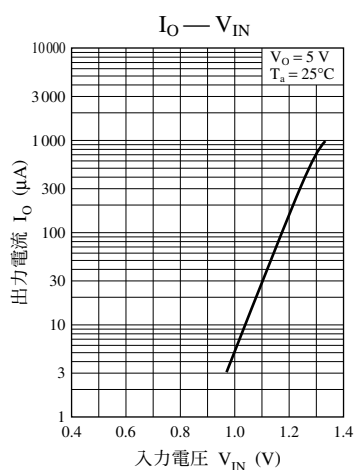
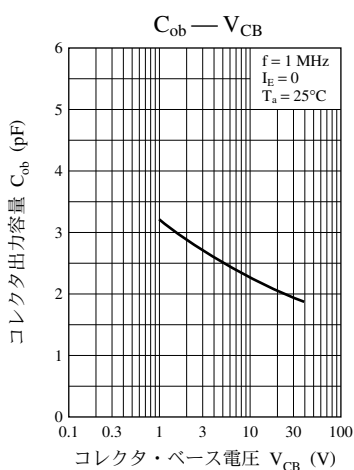
項目	記号	条件	最小	標準	最大	単位
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	$I_{\text{C}} = -10\ \mu\text{A}$, $I_{\text{E}} = 0$	-50			V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_{\text{C}} = -2\ \text{mA}$, $I_{\text{B}} = 0$	-50			V
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	$V_{\text{CB}} = -50\ \text{V}$, $I_{\text{E}} = 0$			-0.1	μA
	I_{CEO}	$V_{\text{CE}} = -50\ \text{V}$, $I_{\text{B}} = 0$			-0.5	μA
エミッタ遮断電流	I_{EBO}	$V_{\text{EB}} = -6\ \text{V}$, $I_{\text{C}} = 0$			-0.2	mA
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{\text{CE}} = -10\ \text{V}$, $I_{\text{C}} = -5\ \text{mA}$	60			
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{\text{CE(sat)}}$	$I_{\text{C}} = -10\ \text{mA}$, $I_{\text{B}} = -0.3\ \text{mA}$			-0.25	V
出力電圧"H"レベル	V_{OH}	$V_{\text{CC}} = -5\ \text{V}$, $V_{\text{B}} = -0.5\ \text{V}$, $R_{\text{L}} = 1\ \text{k}\Omega$	-4.9			V
出力電圧"L"レベル	V_{OL}	$V_{\text{CC}} = 5\ \text{V}$, $V_{\text{B}} = 2.5\ \text{V}$, $R_{\text{L}} = 1\ \text{k}\Omega$			0.2	V
トランジション周波数	f_{T}	$V_{\text{CB}} = 10\ \text{V}$, $I_{\text{E}} = -2\ \text{mA}$, $f = 200\ \text{MHz}$		80		MHz
入力抵抗	R_1		-30%	22	+30%	$\text{k}\Omega$
抵抗比率	R_1/R_2		0.8	1.0	1.2	

共通特性図

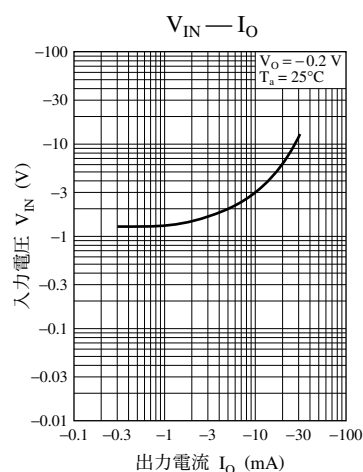
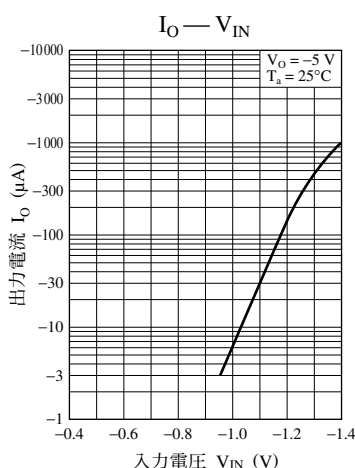
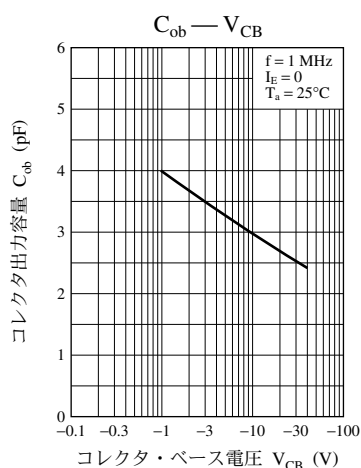
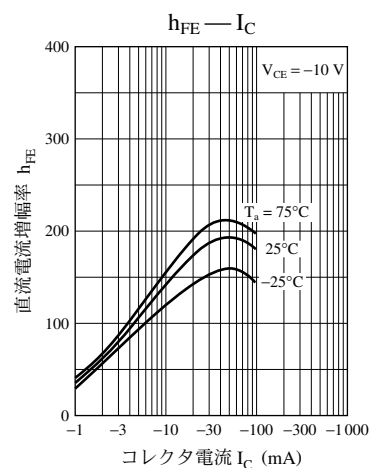
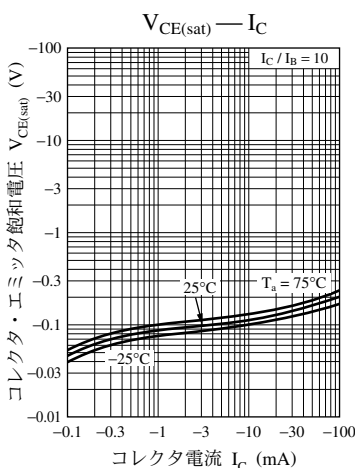
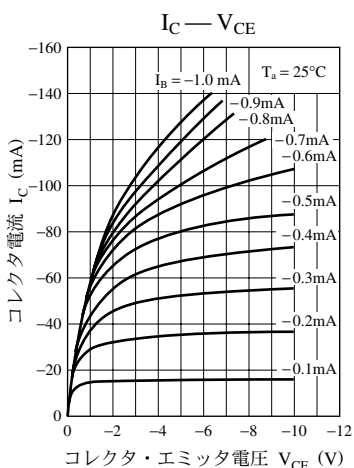


Tr1 部特性図





Tr2 部特性図



本資料に記載の技術情報および半導体のご使用にあたってのお願いと注意事項

- (1) 本資料に記載の製品および技術で、「外国為替及び外国貿易法」に該当するものを輸出する時、または、国外に持ち出す時は、日本政府の許可が必要です。
- (2) 本資料に記載の技術情報は製品の代表特性および応用回路例などを示したものであり、工業所有権等の保証または実施権の許諾を意味するものではありません。
- (3) 本資料に記載されている製品は、標準用途 — 一般電子機器(事務機器、通信機器、計測機器、家電製品など)に使用されることを意図しております。

特別な品質、信頼性が要求され、その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある用途 — 特定用途(航空・宇宙用、交通機器、燃焼機器、生命維持装置、安全装置など)にご使用をお考えのお客様および当社が意図した標準用途以外にご使用をお考えのお客様は、事前に弊社営業窓口までご相談願います。

- (4) 本資料に記載しております製品および製品仕様は、改良などのために予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。したがって、最終的な設計、ご購入、ご使用に際しましては、事前に最新の製品規格書または仕様書をお求め願ひ、ご確認ください。
- (5) 設計に際して、特に最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性については保証範囲内でご使用いただきますようお願い致します。保証値を超えてご使用された場合、その後に発生した機器の欠陥については弊社として責任を負いません。
また、保証値内のご使用であっても、弊社製品の動作が原因でご使用機器が各種法令に抵触しないような冗長設計をお願いします。
- (6) 防湿包装を必要とする製品につきましては、個々の仕様書取り交わしの折、取り決めた条件(保存期間、開封後の放置時間など)を守ってご使用ください。
- (7) 本資料の一部または全部を弊社の文書による承諾なしに、転載または複製することを堅くお断りいたします。

本資料(データシート)ご利用に際しての注意事項

- A. 本資料は、お客様のご用途に応じた適切な松下半導体製品を購入いただくためのご紹介資料です。記載されている販売可能な品種および技術情報等は、予告なく常に更新しておりますので、ご検討にあたっては、早めに弊社営業部門にお問い合わせの上、最新の情報を入手願います。
- B. 本資料は正確を期し、慎重に制作したのですが、記載ミス等の可能性があります。したがって、弊社は資料中の記述誤り等から生じる損害には責任を負わないものとさせていただきます。
- C. 本資料は、お客様ご自身でのご利用を意図しております。したがって、弊社の文書による許可なく、インターネットや他のあらゆる手段によって複製、販売および第三者に提供するなどの行為を禁止いたします。